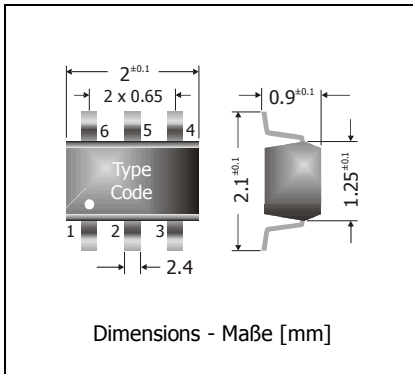


MMBD4448SDW

Fast Switching Surface Mount Si-Planar Diodes – Bridge Configuration Schnelle Si-Planar-Dioden für die Oberflächenmontage – Brückenkonfiguration

Version 2015-02-23



Power dissipation – Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	SOT-363
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



Maximum ratings (T_A = 25°C)

Grenzwerte (T_A = 25°C)

	MMBD4448SDW	
Power dissipation – Verlustleistung	P _{tot}	200 mW ¹⁾
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)	I _{FAV}	150 mA ¹⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	I _{FRM}	300 mA ¹⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	I _{FSM}	0.5 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung	V _{RRM}	100 V
Reverse voltage – Sperrspannung	V _R	80 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _S	-55...+150°C

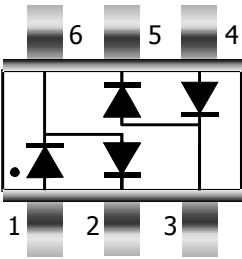
Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

Forward voltage ²⁾ Durchlass-Spannung ²⁾	I _F = 5 mA I _F = 10 mA I _F = 100 mA I _F = 150 mA	V _F	< 720 mV
		V _F	< 855 mV
		V _F	< 1.0 V
		V _F	< 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	T _j = 25°C	V _R = 80 V	I _R < 100 nA
		V _R = 20 V	I _R < 25 nA
	T _j = 150°C	V _R = 75 V	I _R < 50 µA
		V _R = 25 V	I _R < 30 µA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V _R = 0 V, f = 1 MHz		C _T	4 pF
Reverse recovery time – Sperrverzögerung I _F = 10 mA über/through I _R = 10 mA bis/to I _R = 1 mA		t _{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 620 K/W ¹⁾

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Pinning – Anschlussbelegung		Marking – Stempelung
 Fast Switching Diodes Schnelle Dioden 1 = A1, 2 = C1, 3 = AC2 4 = A2, 5 = C2, 6 = AC1		MMBD4448SDW = KB

